

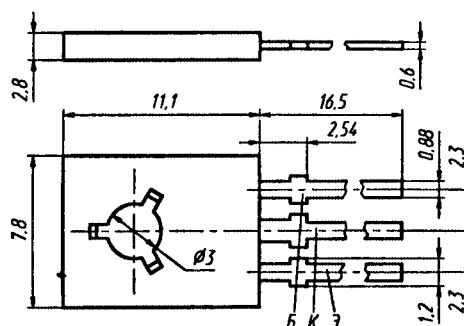
КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 1 г.

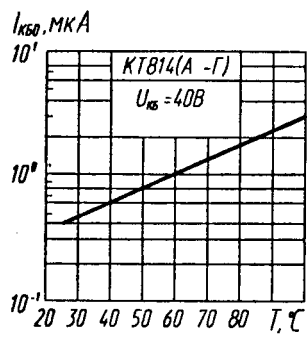
Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод «Искра», г. Ульяновск.

КТ814(А-Г)

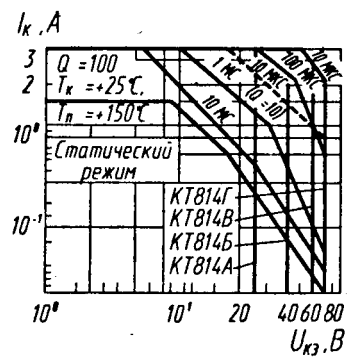


Электрические параметры

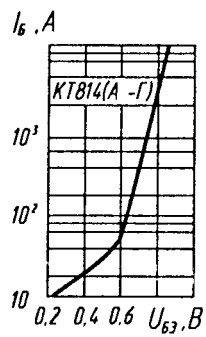
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 2$ В, $I_3 = 0,15$ А, не менее:	
КТ814А, КТ814Б, КТ814В.....	40
КТ712Г	30
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 30$ мА, не менее	
	3 МГц
Граничное напряжение при $I_3 = 50$ мА, не менее:	
КТ814А.....	25 В
КТ814Б.....	40 В
КТ814В.....	60 В
КТ814Г.....	80 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ А, не более	
	0,6 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ А, не более	
	1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 40$ В, не более:	
$T = -40...+25$ °С.....	50 мкА
$T = +100$ °С	1 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 465$ кГц, не более.....	
	60 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0,5$ В, $f = 465$ кГц, не более	
	75 пФ



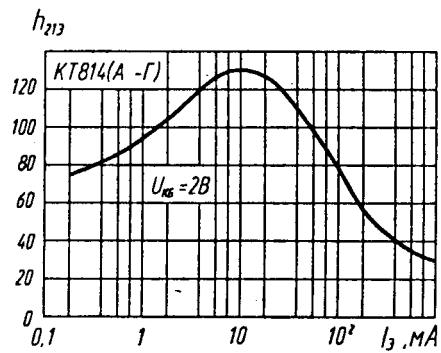
Зависимость обратного тока коллектора от температуры



Область максимальных режимов



Входная характеристика



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при $R_{БЭ} = \infty$:	
КТ814А	25 В
КТ814Б	40 В
КТ814В	60 В
КТ814Г	80 В
при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом:	
КТ814А	40 В
КТ814Б	50 В
КТ814В	70 В
КТ814Г	100 В

Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	1,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10$ мс, $Q \geq 100$	3 А
Постоянный ток базы	0,5 А

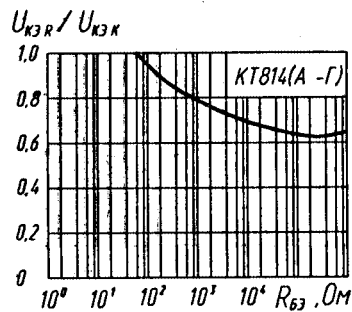
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T = -40...+25$ °С:

с теплоотводом	10 Вт
без теплоотвода	1 Вт
Температура р-п перехода	+125 °С
Температура окружающей среды	-40... $T =$ = +100 °С

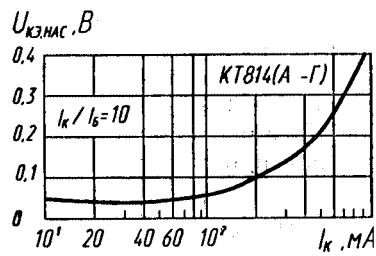
¹ При $T = +25...+100$ °С $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,01 Вт/°С без теплоотвода и на 0,1 Вт/°С с теплоотводом.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

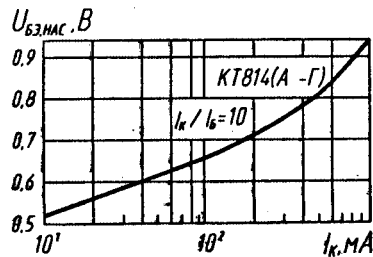
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.



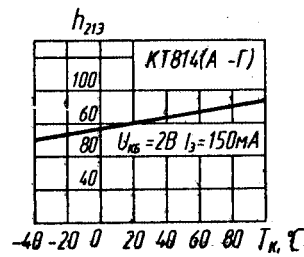
Зависимость постоянного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса